

Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук.

Научный совет РАН «Фундаментальные проблемы элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для ее создания».

Консорциум «Перспективные материалы и элементная база информационных и вычислительных систем»

ПРОГРАММА НАУЧНОЙ СЕССИИ

по теме «Новые материалы с заданными функциями и высокочистые наноматериалы для создания элементной базы информационно-вычислительных и управляющих систем»

(научный руководитель — академик РАН Г.Я. Красников)

26 ноября 2018 г., Президиум РАН (г. Москва, Ленинский пр-т, 32а, корп. Г, эт. 3, Зеленый зал)

- 11:00 Академик РАН Геннадий Яковлевич Красников — открытие научной сессии Совета.
- 11:05 (1) Д.ф.-м.н. Владимир Павлович Попов (ИФП СО РАН), д.ф.-м.н. Константин Васильевич Руденко (ФТИАН РАН) «КНИ-структуры с ультратонкими слоями оксидов гафния и алюминия».
- 11:35 (2) Академик РАН Юрий Васильевич Гуляев, чл.-корр. РАН Сергей Аполлонович Никитов (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), к.ф.-м.н. Дмитрий Владимирович Калябин (МФТИ), к.ф.-м.н. Александр Владимирович Садовников (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, СГУ), к.т.н. Ансар Ризаевич Сафин (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») «Гетероструктуры на основе тяжелых металлов/ферро- или антиферромагнетик для элементной базы вне КМОП».
- 12:05 (3) Д.т.н. Константин Анатольевич Воротилов (МИРЭА) «Химическое осаждение из растворов: материалы и применения».
- 12:35 (4) Д.х.н. Петр Геннадьевич Сенников, д.х.н. Андрей Дмитриевич Буланов (ИХВВ РАН) «Моноизотопный кремний-28 — перспективный материал для практической реализации квантового компьютера».
- 13:05 (5) К.ф.-м.н. Андрей Владимирович Зенкевич, к.ф.-м.н. Андрей Михайлович Маркеев (МФТИ) «Разработка физических основ КМОП-совместимой технологии резистивной и сегнетоэлектрической памяти на новых материалах».
- 13:35 (6) Д.ф.-м.н. Дмитрий Валентинович Рошупкин, к.ф.-м.н. Олег Викторович Кононенко (ИПТМ РАН) «Получение графена методом химического осаждения из газовой фазы и его потенциальное применение в приборах микро и наноэлектроники».
- 14:05 Обед.
- 14:30 (7) К.ф.-м.н. Сергей Викторович Ковешников (ИПТМ РАН) «Современное состояние и перспективы развития твердотельной электроники на основе алмаза и алмазоподобных материалов».
- 15:00 (8) Д.т.н. Сергей Анатольевич Гамкрелидзе (ИСВЧПЭ РАН) «Приборные применения соединений АЗВ5».
- 15:30 (9) Чл.-корр. РАН Владимир Федорович Лукичев, д.ф.-м.н. Константин Васильевич Руденко, к.ф.-м.н. Андрей Валерьевич Мяконьких (ФТИАН РАН) «Продвинутые технологии глубокого анизотропного травления структур в кремнии для микроэлектронных применений».
- 16:00 (10) Академик РАН Геннадий Яковлевич Красников, д.т.н. Евгений Сергеевич Горнев, Аскар Анварович Резванов (АО «НИИМЭ») «Перспективные материалы для микроэлектроники и их применение».
- 16:25 (11) К.х.н. Анатолий Павлович Котков, к.х.н. Юрий Федорович Радьков (АО «НПП «Салют», г. Н. Новгород) «Высокочистые прекурсоры для производства эпитаксиальных структур АЗВ5 (гидридные газы и металлоорганические соединения)».
- 16:55 (12) К.т.н. Сергей Юрьевич Шаповал (ИПТМ РАН) «Разработка технологии изготовления мощных, высокочастотных полевых транзисторов на основе нитрида галлия».
- 17:25 (13) К.т.н. Олег Алексеевич Бузанов, к.ф.-м.н. Алексей Николаевич Забелин, Сергей Александрович Сахаров (ОАО «Фомос-Материалс») «Пьезоэлектрические и сцинтилляционные монокристаллы российского производства».
- 17:55 Подведение итогов работы научной сессии Совета.